

2019年 第80回

応用物理学会秋季学術講演会

会期:2019年9月18日(水)~21日(土) 場所:北海道大学 札幌キャンパス(北海道札幌市)

**講演情報**

一般セッション(口頭講演)

13 半導体 13.3 絶縁膜技術

[19p-E305-1~15] 13.3 絶縁膜技術

2019年9月19日(木) 13:45 ~ 17:45 E305 (E305)

入沢 寿史(産総研)、小林 清輝(東海大)

△: 奨励賞エントリー

▲: 英語発表

▼: 奨励賞エントリーかつ英語発表

空欄: どちらもなし

14:15 ~ 14:30

[19p-E305-3] 室温OER-CVDで成膜したSiO₂膜におけるプロセス条件の影響○萩原 崇之¹、亀田 直人¹、三浦 敏徳¹、森川 良樹¹、花倉 満¹、小杉 亮治²、中村 健²、野中 秀彦² (1.明電舎、2.産総研)キーワード: オゾン酸化、CVD、SiO₂膜

室温成膜技術は、有機ELディスプレイ等フレキシブルエレクトロニクス分野で用いられる耐熱性の低いフレキシブル基板上でのデバイス作製プロセスに必要である。我々は、CVD成膜温度の低温化のため、高純度(約100%)オゾンガスとエチレンガスの反応によるOHラジカル生成技術 (OER法) をCVDに適用し、室温でのSiO₂成膜を可能にした。今回、プロセス条件を変えて成膜し、室温成膜で求められる膜質特性について報告する。